

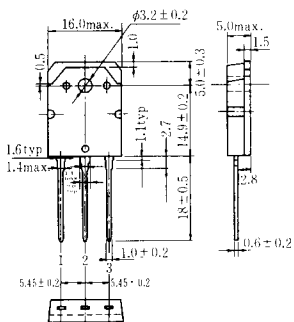
# 2SD1453

シリコン NPN 三重拡散形

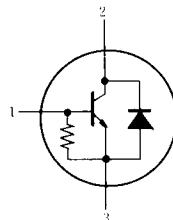
V水平偏向出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT



1. ベース:Base  
2. コレクタ:Collector  
3. エミッタ:Emitter  
(Dimensions in mm)



(TO-3P)

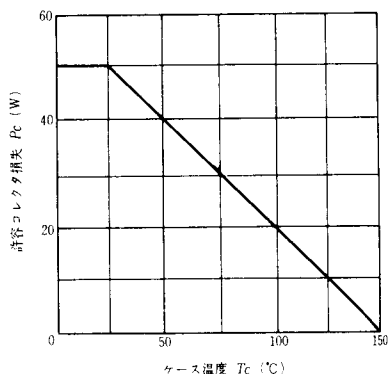
## ■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

項	目	Symbol	2SD1453	Unit
コレクタ・エミッタ電圧		$V_{CES}$	1500	V
エミッタ・ベース電圧		$V_{EBO}$	6	V
コレクタ電流		$I_C$	3	A
せん頭コレクタ電流		$i_{C(peak)}$	3.5	A
サージコレクタ電流		$i_{C(surge)}$	10	A
ダイオード順方向電流		$I_D$	3.5	A
許容コレクタ損失		$P_C^*$	50	W
接合部温度		$T_j$	150	°C
保存温度		$T_{stg}$	-45~+150	°C

\*  $T_C=25^\circ\text{C}$ における許容値。

\* Value at  $T_C=25^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

項	目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ遮断電流		$I_{CES}$	$V_{CE}=1500\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	0.5	mA
エミッタ・ベース破壊電圧		$V_{BR(E)BO}$	$I_E=200\text{mA}, I_C=0$	6	—	—	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C=2.5\text{A}, I_B=0.8\text{A}$	—	—	5.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧		$V_{BE(sat)}$	$I_C=2.5\text{A}, I_B=0.8\text{A}$	—	—	1.5	V
エミッタ・コレクタダイオード電圧		$V_{ECF}$	$I_F=3\text{A}$	—	—	2.2	V
下降時間		$t_f$	$I_{CP}=2.75\text{A}, I_{B1}=0.6\text{A}, I_{B2}=-1.3\text{A}$	—	—	0.8	$\mu\text{s}$